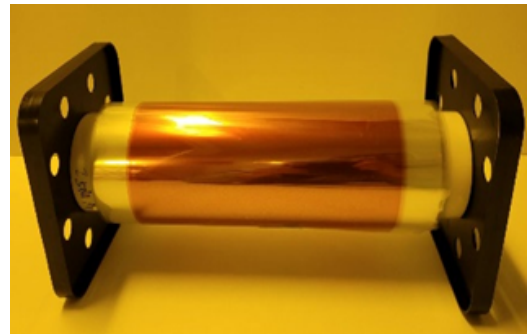


## 技術簡介

現有乾膜材料以負型光阻為主，然而負型光阻照光交聯反應易擴散，影響解析度，無法滿足未來線路高解析度需求(5~20um)。高解析需使用正型光阻，而傳統正型光阻硬脆無法製作成乾膜，且無法KOH/Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>顯影，不適用高階IC載板製程。此材料開發為改質酚系顯影樹脂，並進行配方開發可應用於KOH/Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>顯影之高解析正型乾膜光阻，滿足未來細線路的重分布層與中介層應用需求。

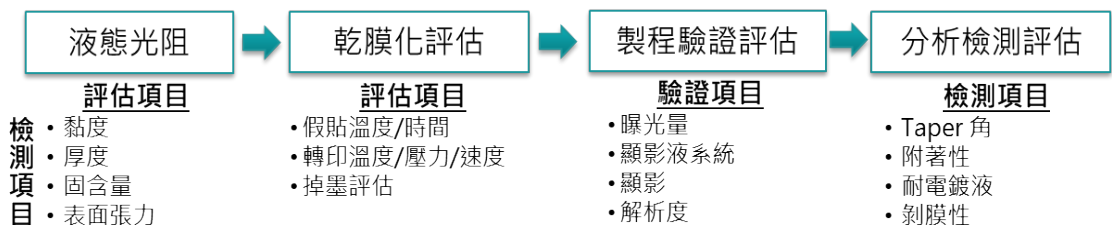
## 技術特色

- 環保具水性KOH/Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>顯影系統
- 改質酚系顯影樹脂，可R2R收卷不脆裂
- 卷材無溶劑，乾膜製程操作環境更友善
- 高解析度，適用於高規格IC載板細線路應用
- 可大面積化且高均勻膜厚轉印性，提升良率

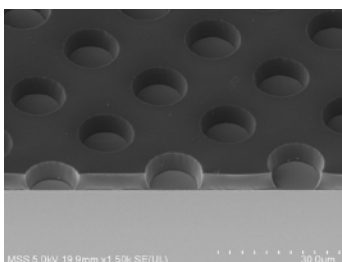


### 驗證平台

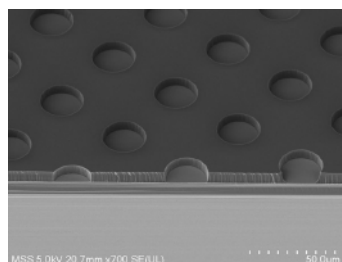
正型乾膜光阻
Cu
wafer



Via = 10 μm



Via = 20 μm



## 應用領域

Copper Pillar、FMM、陶瓷基板  
線路、PCB/IC 載板/Micro LED  
之金屬線路蝕刻